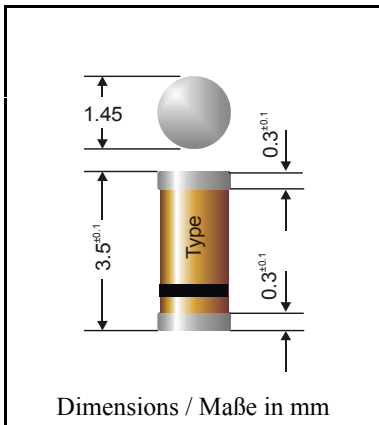


**Surface Mount Si-Schottky Barrier Diodes**

**Silizium-Schottky-Dioden  
für die Oberflächenmontage**



Nominal current Nennstrom	15 mA
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	40...60 V
Glass case MiniMELF Glasgehäuse MiniMELF	SOD 80 DO-213AA
Weight approx. – Gewicht ca.	0.05 g
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	see page 18 siehe Seite 18

**Maximum ratings and Characteristics**

**Grenz- und Kennwerte**

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Period. Spitzensperrspannung $V_{RRM}$ [V]	Forward voltage Durchlaßspannung $V_F$ [V] / $I_F = 1$ mA	$V_F$ [V] / $I_F = 15$ mA
LL 101C	40	< 0.39	< 0.9
LL 101B	50	< 0.4	< 0.95
LL 101A	60	< 0.41	< 1

Power dissipation – Verlustleistung	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$P_{tot}$	400 mW <sup>1)</sup>
Peak forward surge current, 10 $\mu\text{s}$ squarewave Stoßstrom für einen 10 $\mu\text{s}$ Rechteckimpuls	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$I_{FSM}$	2 A
Leakage current, $T_j = 25^\circ\text{C}$ Sperrstrom	LL101C LL101B LL101A	$V_R = 30$ V $V_R = 40$ V $V_R = 50$ V	$I_R$ $I_R$ $I_R$ < 200 nA < 200 nA < 200 nA
Junction capacitance Sperrschichtkapazität	$V_R = 0$ V	$f = 1$ MHz	$C_{tot}$ < 2.2 pF
Reverse recovery time Sperrverzug	$I_F = 5$ mA through/über $I_R = 5$ A to/auf $I_R = 0.5$ mA	$t_{rr}$	typ. 1 ns
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_j$ $T_s$	+200°C - 55...+200°C
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		$R_{thA}$	< 300 K/W <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Valid provided that terminals are kept at ambient temperature  
Gültig wenn Anschlüsse auf Umgebungstemperatur gehalten werden